

Instytut Technologii Elektronowej poszukuje Pracownika/Doktoranta do realizacji zadań w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w programie TECHMATSTRATEG pt. „Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości – WidePOWER. Zadanie 3 - Technologie i materiały do wytwarzania lateralnych tranzystorów wysokonapięciowych AlGaIn/GaN/Si HEMT” (numer projektu: TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017).

Zakres obowiązków:

Do obowiązków Pracownika/Doktoranta należeć będzie projektowanie konstrukcji przyrządów elektronicznych wysokiej mocy i częstotliwości opartych na strukturach AlGaIn/GaN na podłożach krzemowych w celu wytworzenia lateralnych tranzystorów wysokonapięciowych. Dodatkowo od Pracownika/Doktoranta oczekiwać się będzie prac technologicznych nad wytworzeniem tego typu przyrządów.

Otrzymane wyniki prac eksperymentalnych będą mogły stanowić podstawę rozprawy doktorskiej.

Wymagania:

- Tytuł zawodowy magistra elektroniki (preferowany elektroniki ciała stałego) uzyskany maksymalnie trzy lata przed ogłoszeniem naboru.
- Umiejętność pracy z programem Silvaco TCAD lub pokrewnym.
- Umiejętność projektowania w programie AutoCAD lub pokrewnym.
- Predyspozycje i zamiłowanie do prac eksperymentalnych w zakresie technologii.
- Znajomość obsługi urządzeń technologicznych, takich jak: urządzenia do naświetlania, do trawienia plazmowego, do osadzania warstw metodą rozpylania katodowego będzie dodatkowym atutem.
- Płynna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

- Umowę o pracę w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie, Al. Lotników 32/46 na czas realizacji projektu.
- Możliwość prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie tranzystorów AlGaIn/GaN HEMT.
- Przestrzeń na własną inicjatywę badawczą w dziedzinie projektu.
- Możliwość zdobycia wiedzy w zakresie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych.
- Pracę w dynamicznym zespole w nowoczesnym laboratorium technologicznym.

Dokumenty:

Zgłoszenie konkursowe powinno zostać przesłane w formie elektronicznej do dr hab. inż. Anny Szerling na adres szering@ite.waw.pl. Powinno zawierać: List motywacyjny, życiorys, kopię dyplomu mgr, informacje o przedmiocie pracy mgr, ewentualnie spis publikacji naukowych, informację o aktywności w kołach naukowych, informacje o pozanaukowej/studenckiej aktywności, zainteresowaniach technicznych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.